

層状ナノシート

従来技術に比して、低コストで高品質な層状 MoS_2 、層状グラファイトが作成可能です。

概要

低消費電力・新機能性を持つ次世代ナノデバイスへの出口として MoS_2 が注目されている。現在の作成方法は、イオンを挿入し層間距離を広げ剥離する手法であるインターカレーションを用いる方法や、薄膜成分を含む原料ガスを供給し基板表面に膜を堆積する手法である化学気相蒸着（CVD）法が存在するが、前者は低品質であり、後者は高価で生産性が低いといった課題があった。

本発明は、上記課題を解決する低コストで、層間の残留物が少なく、配向性が高いといった高品質な新規層状ナノシートの作製方法に関する。層状ナノシートの作製例は、 MoS_2 、グラファイトであるが、それ以外の層状ナノシートも作製可能である。

応用例

- ・電流のオン/オフ比が極めて高い次世代半導体材料
- ・潤滑剤
- ・電池電極材、等

知的財産データ

知財関連番号 : PCT/JP2022/032879
発明者 : 林大和、滝澤博胤、石井大悟、江波戸優介、澤口京佑
整理番号 : T20-3099



性能・特徴等

未公開のため秘密保持条項を含む、技術移転にかかる契約※締結の上、開示可能です。
※オプション契約、学術指導契約、共同研究契約、等

お問い合わせ



株式会社東北テクノアーチ

TEL 022-222-3049

お問い合わせフォームは[こちら](#)

本資料をダウンロード



お問い合わせ

<https://www.t-technoarch.co.jp/contact.html>



発明案件を随時更新中

<https://www.t-technoarch.co.jp/anken.php>



LinkedIn ページをフォロー

<https://www.linkedin.com/company/tohoku-techno-arch>



Leading you to Successful Industrialization



株式会社

東北テクノアーチ

TOHOKU TECHNO ARCH